

# **SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA**

Uprzejmie zawiadamiamy, że w **ŚRODĘ**

**21 maja 2008 r., o godz. 10:00**

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

**Dr inż. Lech DOBRZAŃSKI**

Institut Technologii Materiałów Elektronicznych

wygłosi referat na temat:

## **„Detektory ultrafioletu z azotku galu oraz technologia tranzystorów HEMT z GaN”**

W trakcie seminarium zostanie omówione widmo promieniowania słonecznego, definicje zakresów UV, wnikanie promieniowania w półprzewodnik, konstrukcje detektorów i ich specyficzne własności, technologia i wyniki charakteryzacji.

Zostaną przedstawione własności piezoelektryczne GaN i AlGaN, struktura pasmowa HEMT (High Electron Mobility Transistor) z uwzględnieniem ładunków polaryzacyjnych. Omówiona zostanie konstrukcja i technologia tranzystorów oraz wyniki ich charakteryzacji. Na zakończenie przedstawię wnioski nt. perspektyw rozwoju tranzystorów HEMT z GaN.

Serdecznie zapraszamy

Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski